

MBR20020CT thru MBR20040CTR

Silicon Power Schottky Diode

 $V_{RRM} = 20 \text{ V} - 100 \text{ V}$ $I_F = 200 \text{ A}$

Features

- High Surge Capability
- Types up to 100 V V_{RRM}

Twin Tower Package



Maximum ratings, at T_i = 25 °C, unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

Parameter	Symbol	Conditions	MBR20020CT (R)	MBR20030CT (R)	MBR20035CT (R)	MBR20040CT (R)	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		20	30	35	40	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		14	21	25	28	V
DC blocking voltage	V_{DC}		20	30	35	40	V
Continuous forward current	I _F	T _C ≤ 136 °C	200	200	200	200	Α
Surge non-repetitive forward current, Half Sine Wave	I _{F,SM}	$T_C = 25 ^{\circ}\text{C}, t_p = 8.3 \text{ms}$	1500	1500	1500	1500	Α
Operating temperature	T _j		-40 to 175	-40 to 175	-40 to 175	-40 to 175	°C
Storage temperature	T _{stg}		-40 to 175	-40 to 175	-40 to 175	-40 to 175	°C

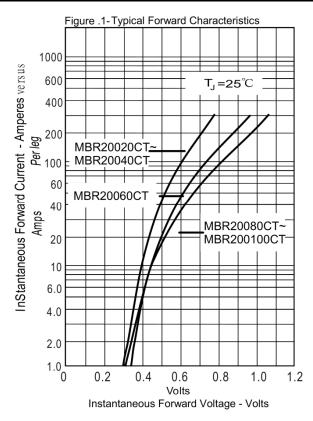
Electrical characteristics, at Tj = 25 °C, unless otherwise specified

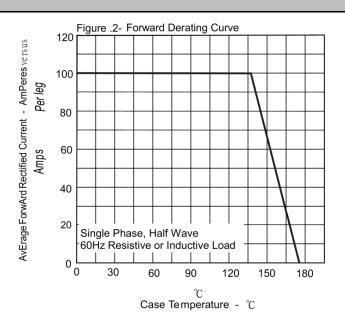
Parameter	Symbo	I Conditions	MBR20020CT (R) MBR20030CT (R) MBR20035CT (R)	MBR20040CT (R)	Unit
Diode forward voltage	V_{F}	I _F = 100 A, T _j = 25 °C	0.65	0.65	0.65	0.65	V
Reverse current		$V_R = 20 \text{ V}, T_j = 25 ^{\circ}\text{C}$		5	5	5	mA
	IR	$V_R = 20 \text{ V}, T_j = 125 ^{\circ}\text{C}$	200	200	200	200	
Thermal characteris	tics						
Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}		0.5	0.5	0.5	0.5	°C/W

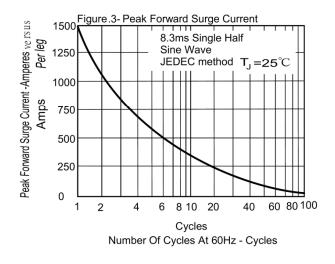


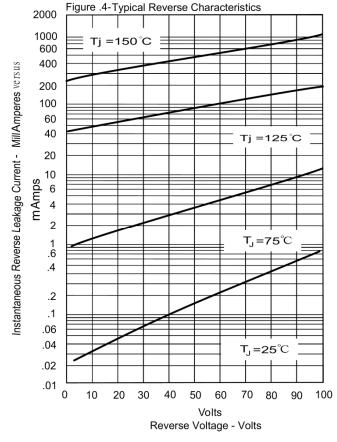


MBR20020CT thru MBR20040CTR









ПОСТАВКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001 Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г. Москва, ул. Щербаковская д. 3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru moschip.ru_6 moschip.ru_4 moschip.ru_9